

电可改写非挥发存储器



作者：于宗光，郝跃著

出版社：北京：国防工业出版社

出版日期：2002.04

总页数：227

介绍：本书介绍了EEPROM单元结构的变革及发展方向，EEPROM的电路设计技术，EEPROM中隧道氧化层的可靠性研究，电可改写集成电路的应用等12章内容。

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/11169189.html>）查找全本阅读方式

电可改写非挥发存储器 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/11169189.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/11169189.html>

书名：电可改写非挥发存储器